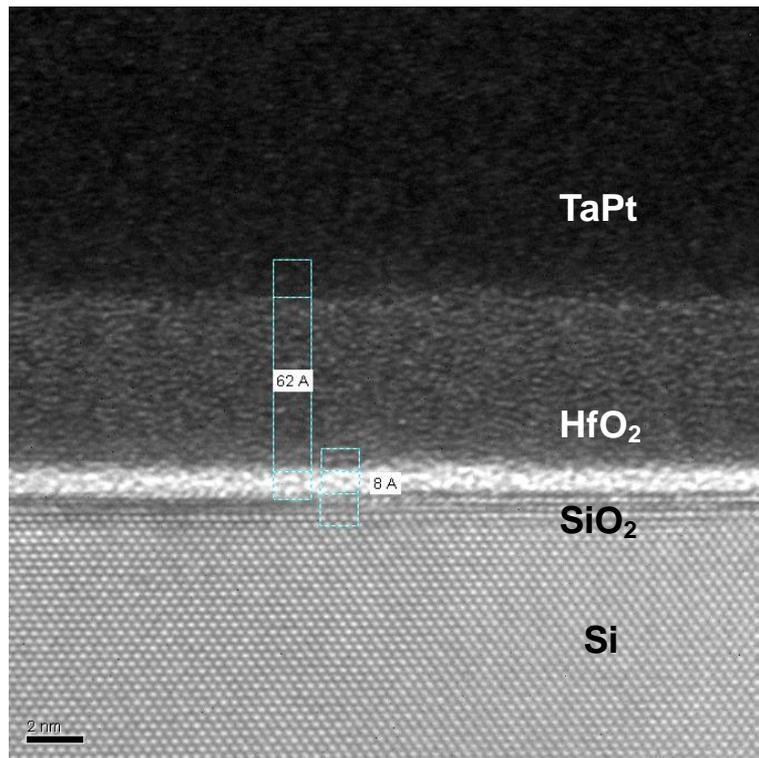
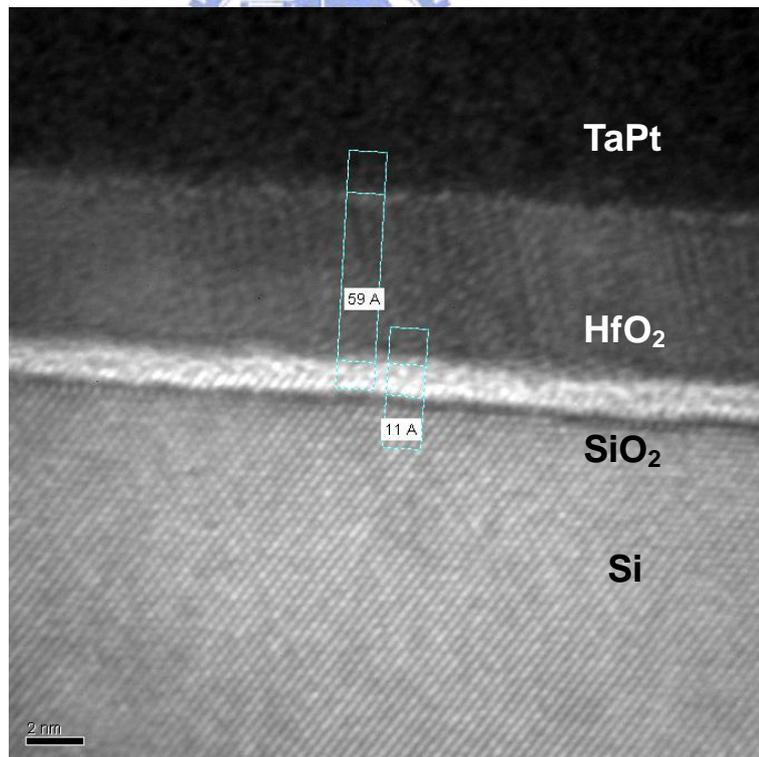


(b)

圖 3-1 SC1 前處理二氧化鈺試片的 X-TEM 圖。(a)As，(b) 經過 PDA 600°C 退火處理。



(a)



(b)

圖 3-2 RTO 前處理二氧化鈦試片的 X-TEM 圖。(a)As，(b) 經過 PDA 600°C 退火處理。

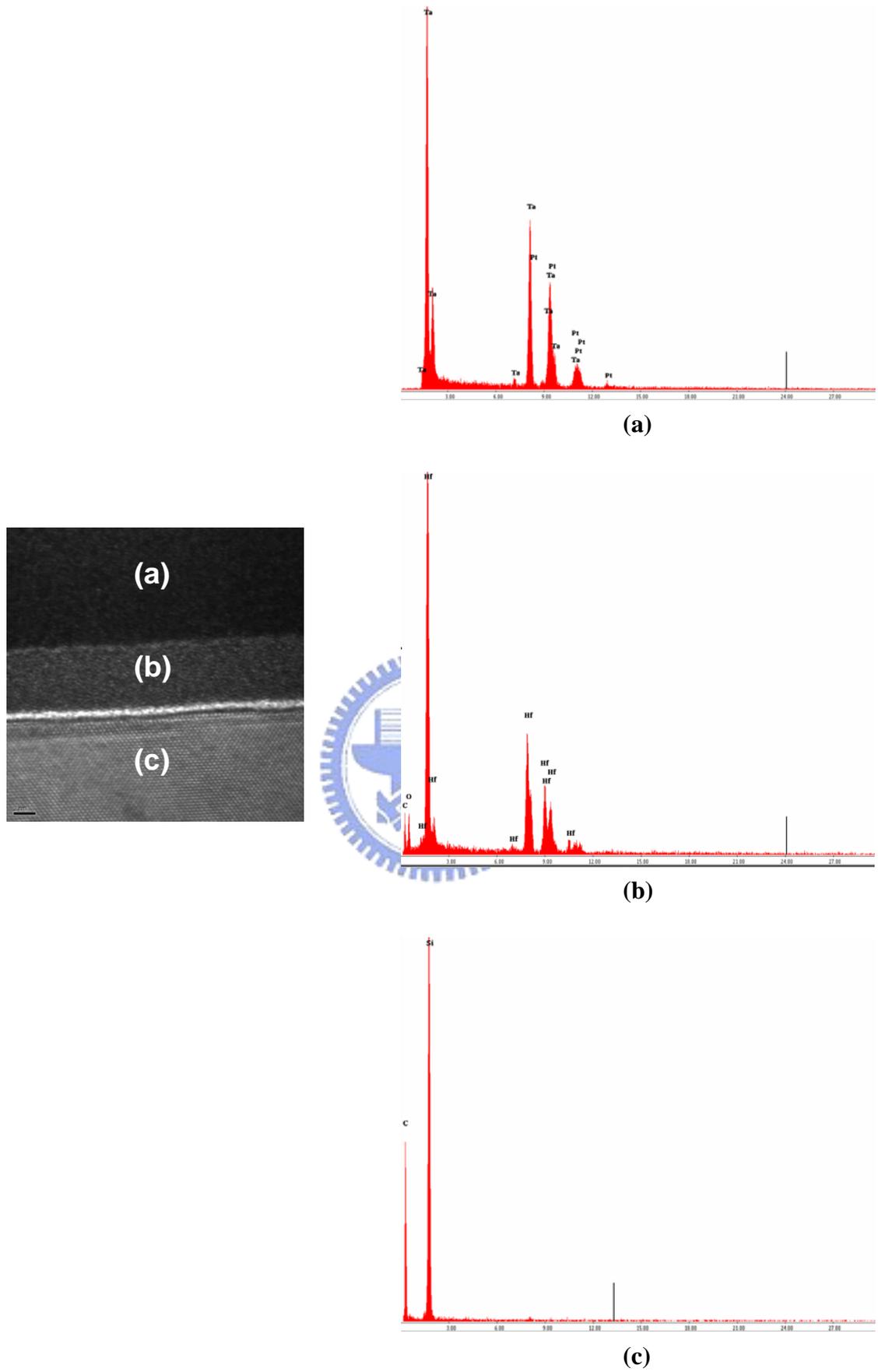
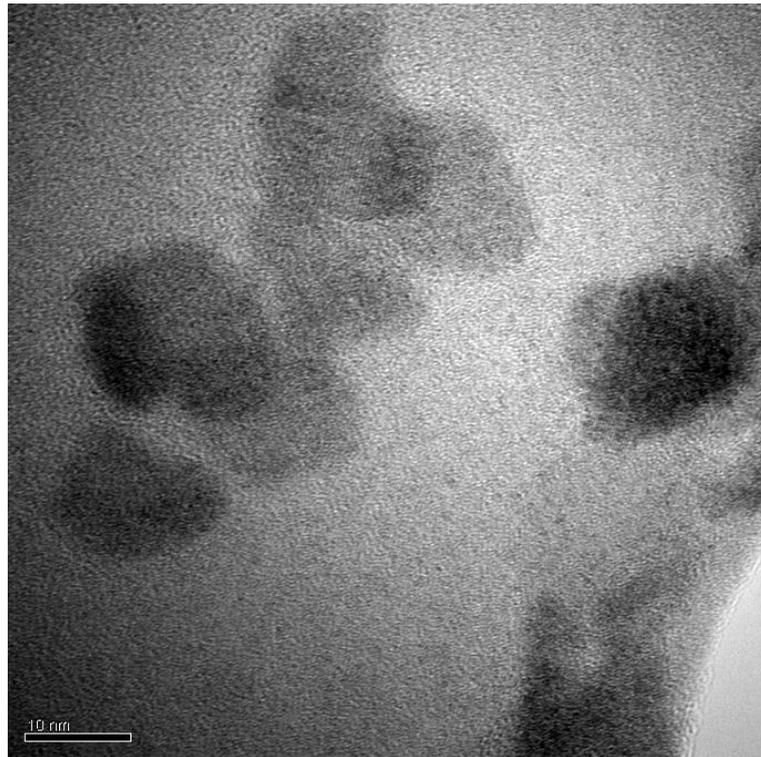


圖 3-3 利用 EDS 分析薄膜的組成成分。(a)TaPt 閘極，(b)二氧化鈦介電層，(c)矽基板。

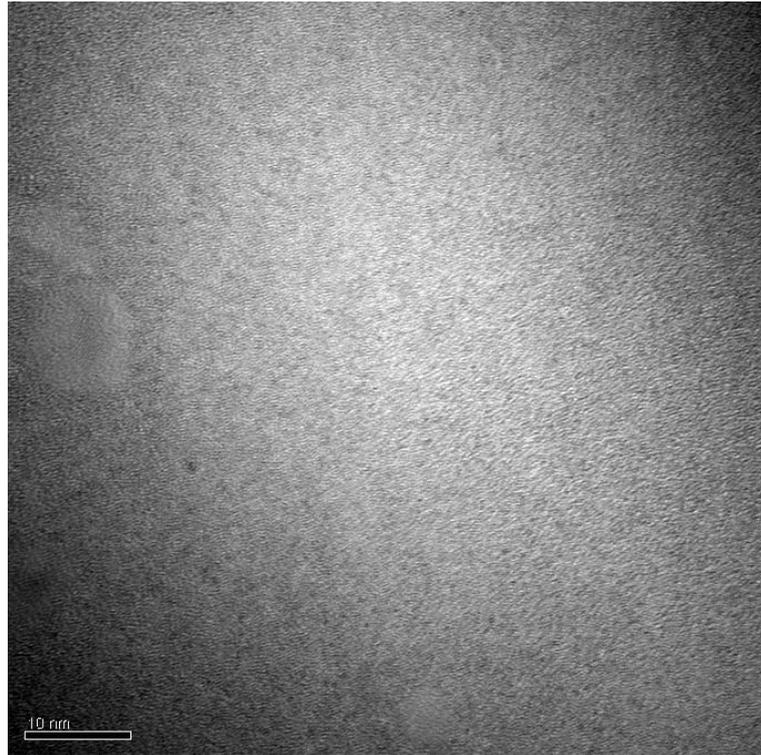


(a)

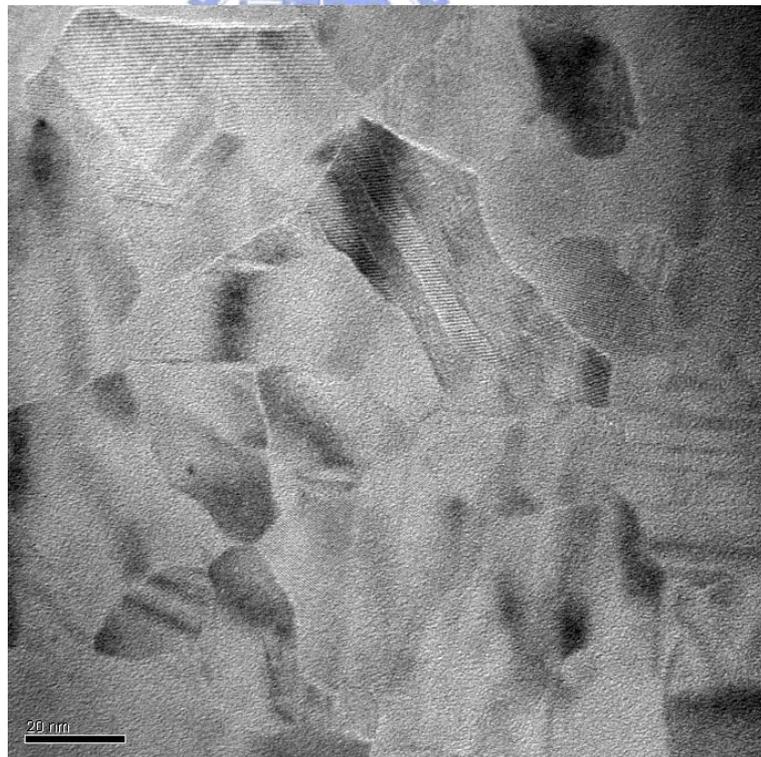


(b)

圖 3-4 SC1 前處理二氧化鋯試片的 PV-TEM 圖。(a)As，(b) 經過 PDA 600°C 退火處理。

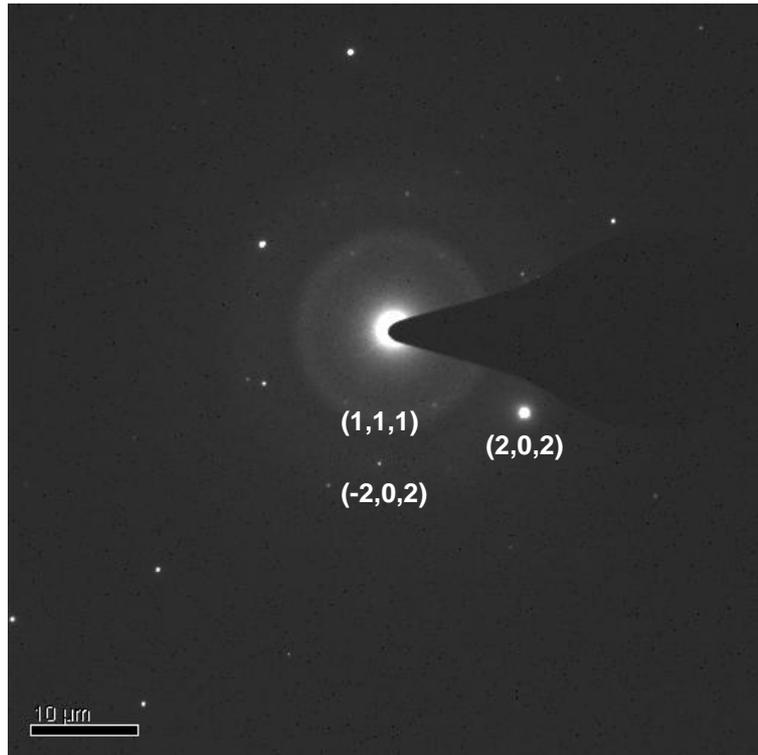


(a)

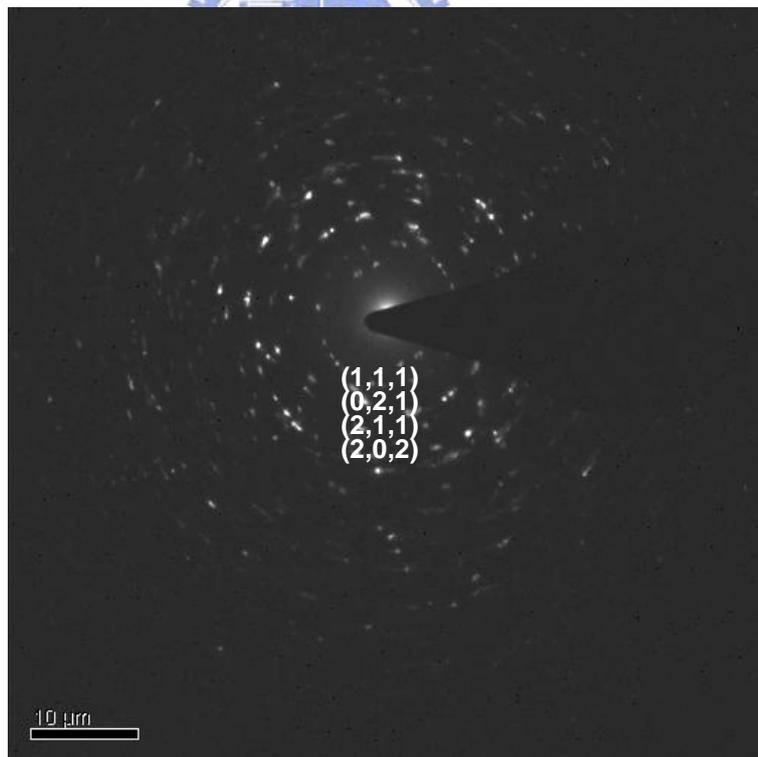


(b)

圖 3-5 RTO 前處理二氧化鈣試片的 PV-TEM 圖。(a)As, (b) 經過 PDA 600°C 退火處理。

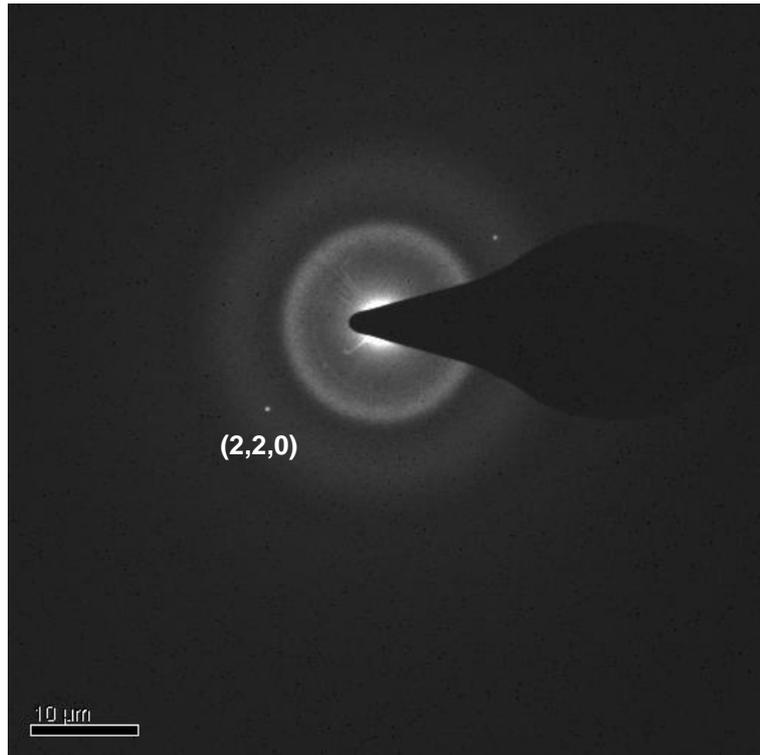


(a)

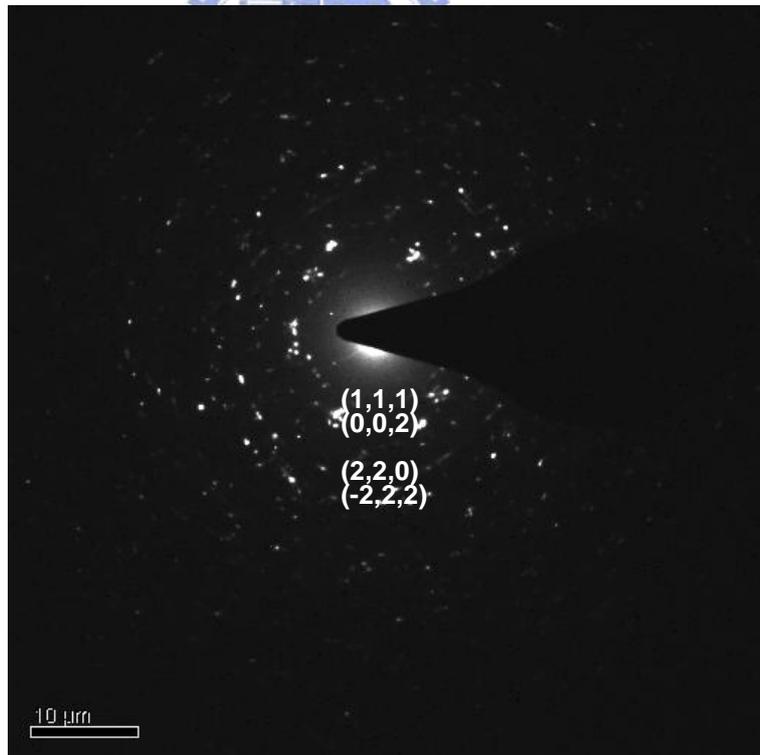


(b)

圖 3-6 SC1 前處理二氧化鈣試片的 PV-TEM 繞射圖形。(a)As，(b) 經過 PDA 600°C 退火處理。



(a)



(b)

圖 3-7 RTO 前處理二氧化鈺試片的 PV-TEM 繞射圖形。(a)As，(b) 經過 PDA 600°C 退火處理。